

(19) (KR)
(12) (A)

(51) 。 Int. Cl.⁷ (11) 10-2004-0043892
G02F 1/136 (43) 2004 05 27

(21) 10-2002-0072331
(22) 2002 11 20

(71) 136-1

(72) 237

103 1204

332 307

6 604 802

(74)

:

(54)

(cross talk) 가
; , 1 , 2 3
; , 3 ;
; 2 , 1, 2, 3 ;
1, 2, 3 .

2e

1a 1e .
2a 2e 1a 1e .

()

5 : 10 :

15 : 20 :

25 : 1 30 : 2

35 : 3 40 :

45 : / 55a, 55b, 55c :

60 : 65, 65a, 65b, 65c :

70 :

s talk) 가 , (cros

, ()

. , Cst-on-gate

, 가 ()

, Cst-on-gate

가 가 가

, , (,)

, , 가 가
(cross talk)가

, 가가 ,
가

; , 1 , 2 3
 ; 3 ;
 2 1, 2, 3 ; 1, 2,
 3 .
 ()
 , .
 1a 1e , 2a 2e 1a 1e ,
 .
 , 1a 2a , (5) (10), (15) (20)
 , - - (Cst-on-gate) (10) (15)
 .
 5) , 1b 2b (10), (15) (20) (25), 2 (30) 3 (35) .
 , 2 (30) 3 (35) 가 .
 (30) , 1 (25) 3 (35) SiNx SiC, Al₂O₃ , 2
 가 SiO₂ SiON 500 10,000 (35) (15)
 , 3 (35) (40) .
 (35) () 1 (17) 가 2 (30) , (40) 3
 , (30) CHF₃ 가 (40) 3 (35) SF₆, O₂, He 가 , 2
 EPD(End Point Detect) 2
 , 1c 2c , / (45) / (45a) ,
 .
 , 1d 2d , (60) , (55a) .
 (10)
 , (15) 가 3 (35)
 (55b)
 , (20) (60) 3, 2, 1 (25) (55c)
 .
 1 (25) , (60) SiN (55c) (60) (60)
 40) 3 (35) , 2 (30) (55b) 가 SiO₂ (60), ()
 .
 , 1, 2 (25)(30) , 1d
 , (15) 1, 2 (25)(30) 가

.
1e 2e (65)(65a)(65b)(65c)
(15) (70)
가 1 3 2 3 1 가 2
1, 2 1, 2 3
(cross-talk)
가 가 가

- (57)
1.
1 2 3
2, 3 1, 2, 3
2. 가
3.
4.
5. 3 500 10,000

6.

1

,

1

3

SiNx, SiC

Al₂O₃

.
7.

1

,

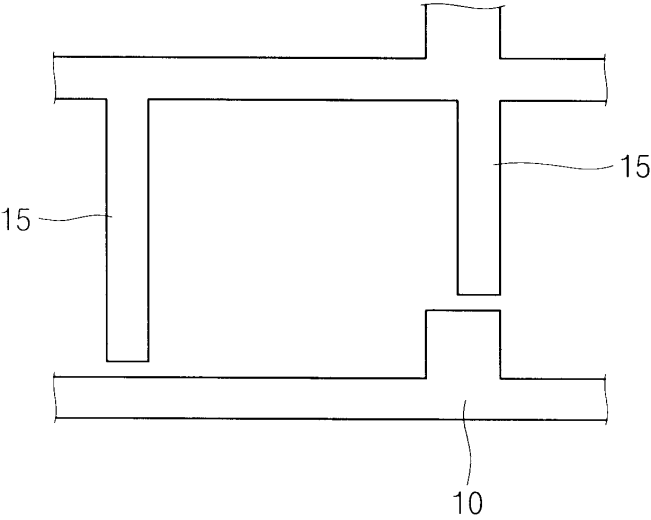
2

SiON

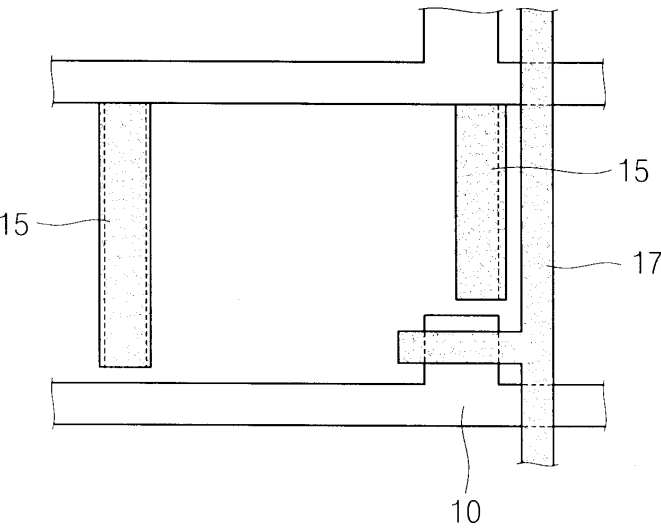
SiO₂

.

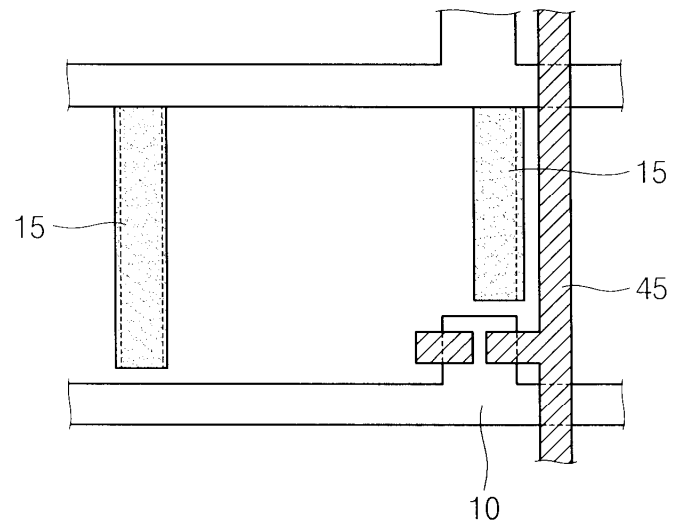
1a



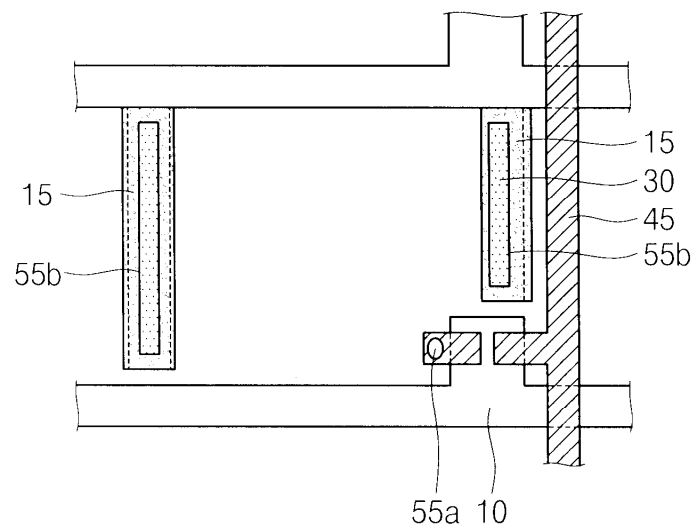
1b



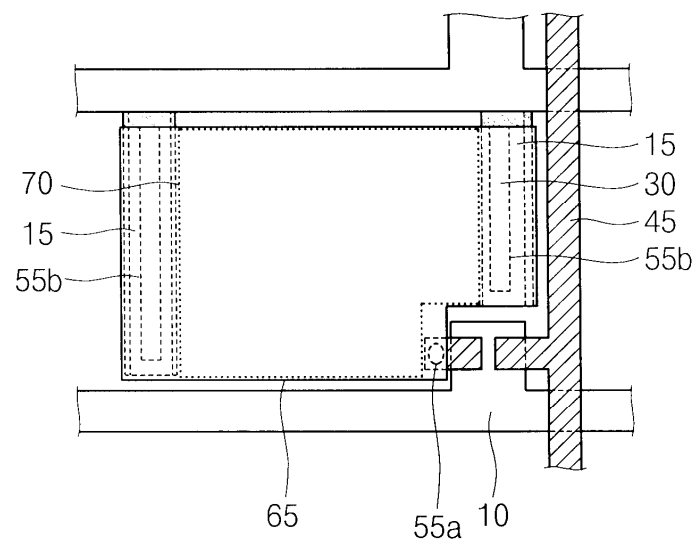
1c



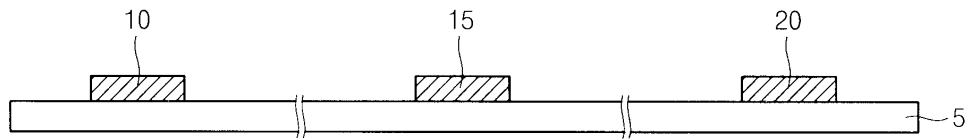
1d



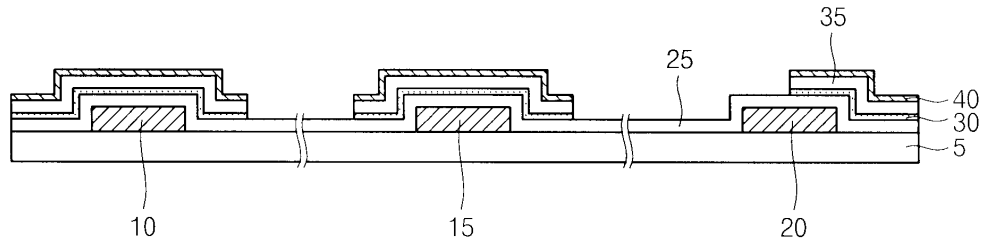
1e



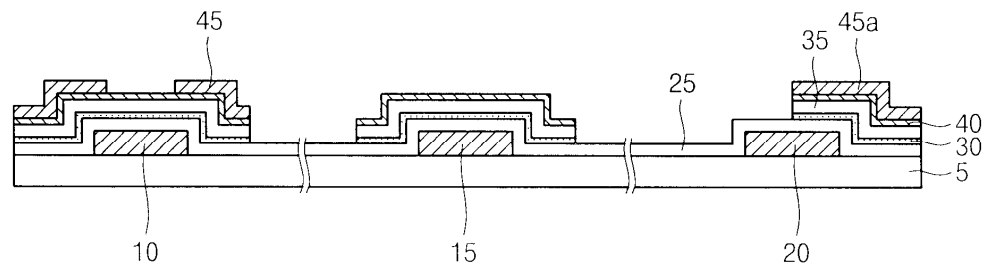
2a



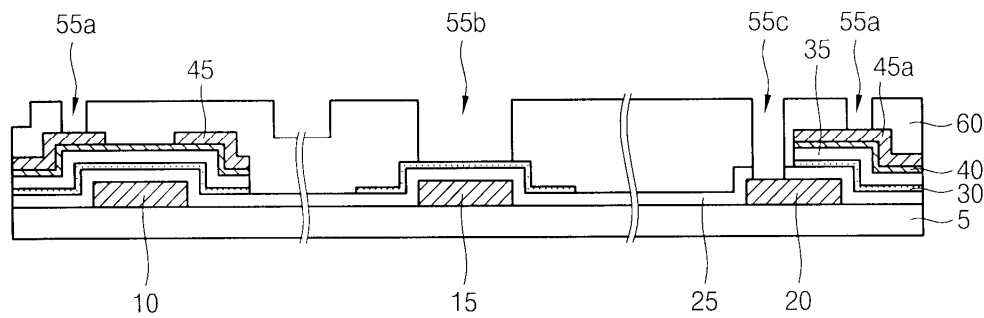
2b



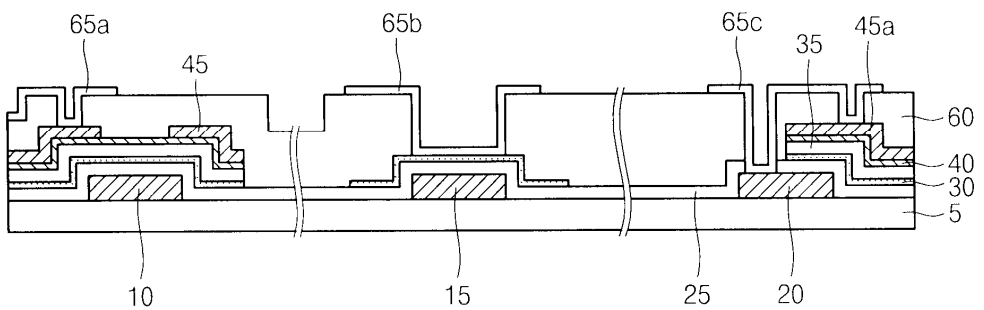
2c



2d



2e



专利名称(译)	液晶显示装置的制造方法		
公开(公告)号	KR1020040043892A	公开(公告)日	2004-05-27
申请号	KR1020020072331	申请日	2002-11-20
[标]申请(专利权)人(译)	HYDIS TECH HYDIS技术有限公司		
申请(专利权)人(译)	하이디스테크놀로지주식회사		
当前申请(专利权)人(译)	하이디스테크놀로지주식회사		
[标]发明人	SON KYOUNGSEOK 손경석 LEE HONYEON 이호년 CHO JINHUI 조진희 KIM HYUNJIN 김현진		
发明人	손경석 이호년 조진희 김현진		
IPC分类号	G02F1/136		
CPC分类号	G02F1/133345 G02F1/136209 G02F1/136213 G02F1/136286 G02F1/1368		
代理人(译)	赵龙HYUN		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

根据本发明，保护膜形成在形成非晶层的非晶层上的源极和漏极的步骤的上部：栅极电极上部：结果。并且这选择性地被图案化并且它包括源电极，相应的第一和第二暴露第二绝缘层在存储电极和焊盘电极上，以及形成3个通孔的步骤和在保护电极上形成透明电极的步骤电影包括第一和第二，以及3个通孔。

